

MITSUBISHI

< IGBT モジュール >

CM1400DUC-24NF

大電力スイッチング用
絶縁形



2素子入り

- コレクタ電流 I_C
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CES}
最大接合温度 T_{jmax}

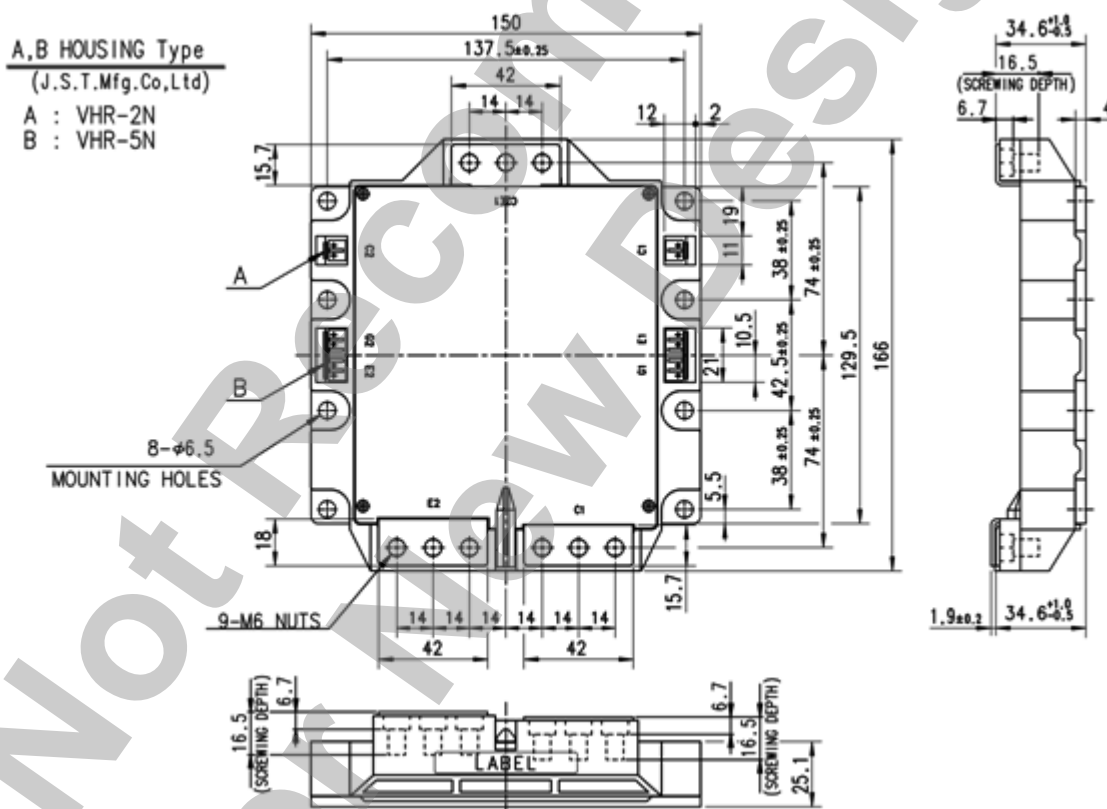
1400 A
1200 V
150 °C
- フラットベース形
 - 銅ベース板（めっきレス）
 - RoHS 指令対応
 - UL Recognized under UL1557, File E323585

用途

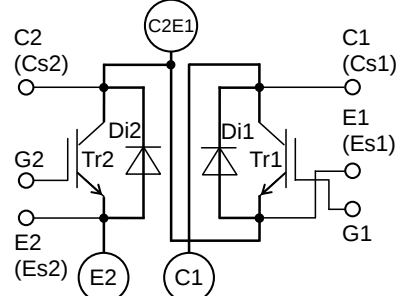
インバータ装置，サーボアンプ，電源装置 など

外形及び接続図

単位：mm



接続図



最大定格（指定のない場合、 $T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）

記号	項目	条件	定格値	単位
V_{CES}	コレクタ・エミッタ間電圧	G-E 間短絡	1200	V
V_{GES}	ゲート・エミッタ間電圧	C-E 間短絡	± 20	V
I_C	コレクタ電流	直流, $T_C=94\text{ }^{\circ}\text{C}$ (注2, 4)	1400	A
I_{CRM}		パルス, 繰返し (注3)	2800	
P_{tot}	コレクタ損失	$T_C=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (注2, 4)	8925	W
I_E (注1)	エミッタ電流	直流 (注2)	1400	A
I_{ERM} (注1)		パルス, 繰返し (注3)	2800	
V_{isol}	絶縁耐電圧	全端子・ベース板間, 実効値, $f=60\text{ Hz}$, AC 1 分間	2500	V
T_J	接合温度	-	$-40 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	保存温度	(注7)	$-40 \sim +125$	

電気的特性（指定のない場合、 $T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）

記号	項目	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
I_{CES}	コレクタ・エミッタ間遮断電流	$V_{CE}=V_{CES}$, G-E 間短絡	-	-	1.0	mA
I_{GES}	ゲート・エミッタ間漏れ電流	$V_{GE}=V_{GES}$, C-E 間短絡	-	-	1.5	μA
$V_{GE(th)}$	ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$I_C=140\text{ mA}$, $V_{CE}=10\text{ V}$	6	7	8	V
V_{CESat}	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$I_C=1400\text{ A}$, $V_{GE}=15\text{ V}$, 試験回路図参照 (注5)	$T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.8	2.5	V
			$T_J=125\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.0	-	
C_{ies}	入力容量	$V_{CE}=10\text{ V}$, G-E 間短絡	-	-	220	nF
C_{oes}	出力容量		-	-	25	
C_{res}	帰還容量		-	-	4.7	
Q_G	ゲート電荷量	$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_C=1400\text{ A}$, $V_{GE}=15\text{ V}$	-	7200	-	nC
$t_{d(on)}$	ターンオン遅延時間	$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_C=1400\text{ A}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, $R_G=0.22\text{ }\Omega$, 誘導負荷	-	-	800	ns
t_r	上昇時間		-	-	300	
$t_{d(off)}$	ターンオフ遅延時間		-	-	1000	
t_f	下降時間		-	-	300	
V_{EC} (注1)	エミッタ・コレクタ間電圧	$I_E=1400\text{ A}$, G-E 間短絡, 試験回路図参照 (注5)	$T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.5	3.2	V
			$T_J=125\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.1	-	
t_{rr} (注1)	逆回復時間	$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_E=1400\text{ A}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, $R_G=0.22\text{ }\Omega$, 誘導負荷	-	-	700	ns
Q_{rr} (注1)	逆回復電荷		-	90	-	μC
E_{on}	ターンオンスイッチング損失	$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_C=I_E=1400\text{ A}$,	-	122.8	-	mJ
E_{off}	ターンオフスイッチング損失	$V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, $R_G=0.22\text{ }\Omega$, $T_J=125\text{ }^{\circ}\text{C}$,	-	161.2	-	
E_{rr} (注1)	逆回復損失	誘導負荷, 1 パルスあたり	-	136.9	-	mJ
$R_{CC'+EE'}$	内部配線インダクタンス	主端子-チップ間, 1 素子あたり, $T_C=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (注4)	-	0.286	-	m Ω
r_g	内部ゲート抵抗	1 素子あたり	-	1.0	-	Ω

熱的特性

記号	項目	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$R_{th(j-c)Q}$	熱抵抗	接合・ケース間, インバータ部 IGBT, 1 素子あたり (注4)	-	-	14	K/kW
$R_{th(j-c)D}$		接合・ケース間, インバータ部 FWD, 1 素子あたり	-	-	23	
$R_{th(c-s)}$	接触熱抵抗	ケース・ヒートシンク間, 1/2 モジュールあたり, 熱伝導性グリース塗布 (注4, 6)	-	12	-	K/kW

機械的特性

記号	項目	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
M_t	締付けトルク	主端子 M 6 ねじ	3.5	4.0	4.5	N・m
M_s	締付けトルク	取付け M 6 ねじ	2.5	4.0	4.5	N・m
d_s	空間距離	端子間	24	-	-	mm
		端子・ベース板間	33	-	-	
d_a	沿面距離	端子間	14	-	-	mm
		端子・ベース板間	33	-	-	
m	質量	—	-	1450	-	g
e_c	ベース板平面度	X, Y1, Y2 各中心線上 (注8)	-50	-	+100	μm

注 1. フリーホイールダイオード (FWD) の定格又は特性を示します。

2. 接合温度は、最大接合温度 (T_{jmax}) 以下です。

3. パルス幅及び繰返し率は、素子の温度上昇が、最大接合温度 (T_{jmax}) を越えない値とします。

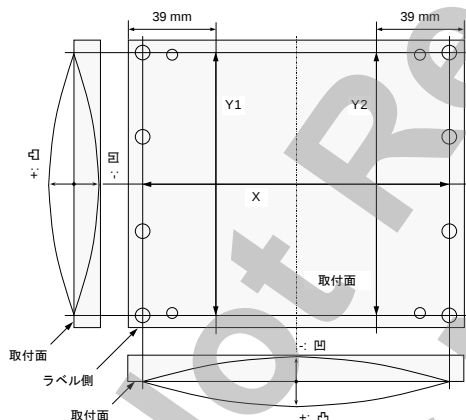
4. ケース温度 (T_c) 及びヒートシンク温度 (T_s) の定義点は、チップ直下におけるベース板及びヒートシンクの表面です。
チップ中心位置は、チップ配置図のとおりです。

5. パルス幅及び繰返し率は、素子の温度上昇が無視できる値とします。

6. 接触熱抵抗の標準値は、熱伝導率 $\lambda=0.9 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ の放熱用グリースを使用したときの値です。

7.

8. ベース板 (取付面) 平面度測定箇所 (X, Y1 及び Y2) は、下図のとおりです。



9 本書に記載されている会社名、商品名などは一般に各社の商標又は登録商標です。

CM1400DUC-24NF

大電力スイッチング用

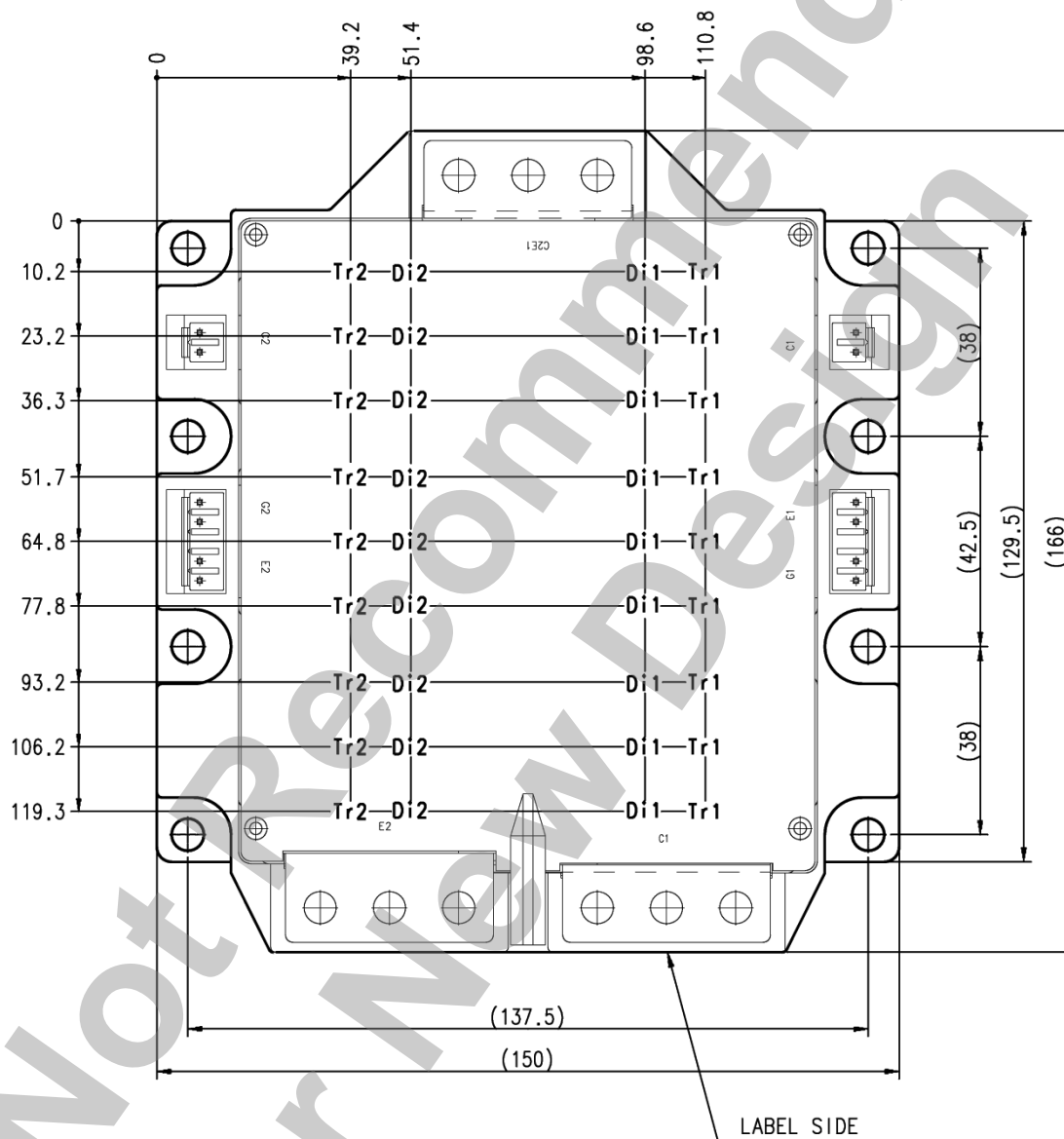
絶縁形

推奨動作条件

記号	項目	条件	規格値			Unit
			最小	標準	最大	
V_{CC}	電源電圧	C1-E2 端子間	-	600	800	V
V_{GEon}	ゲート（駆動）電圧	G1-Es1/G2-Es2 端子間	13.5	15.0	16.5	V
R_G	外部ゲート抵抗	1 素子あたり	0.22	-	2.2	Ω

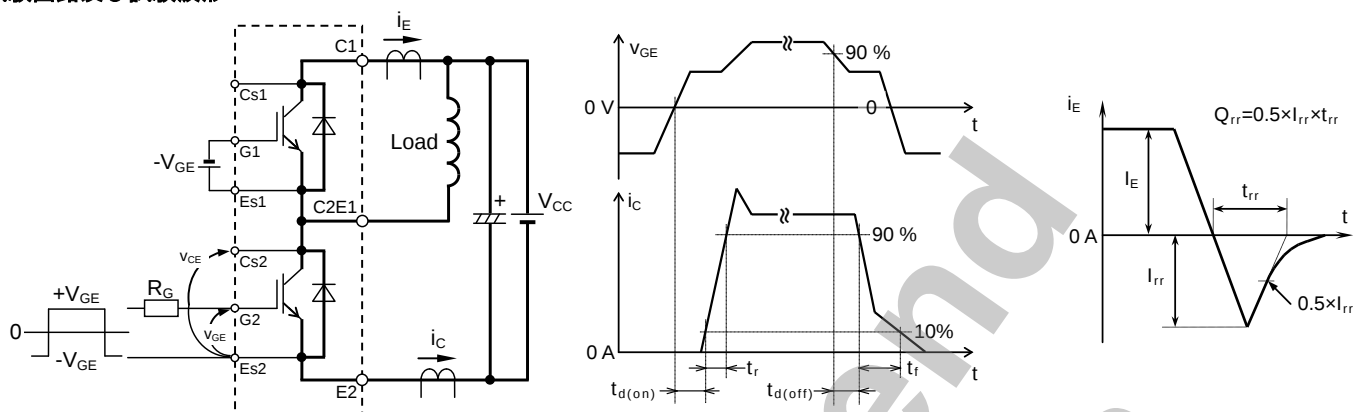
チップ配置図 (Top view)

単位 : mm, 公差 : ± 1 mm



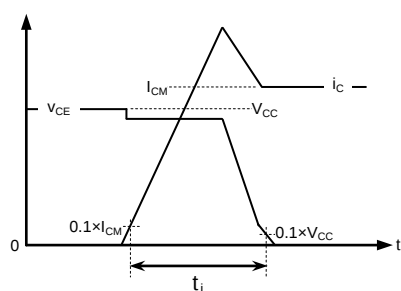
Tr1/Tr2: IGBT, Di1/Di2: FWD
記号は、それぞれのチップの中心を示します。

試験回路及び試験波形

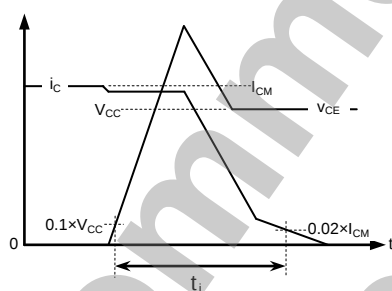


スイッチング特性試験回路及び試験波形

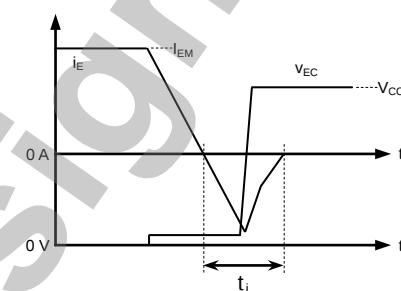
逆回復特性試験波形



IGBT ターンオンスイッチング損失



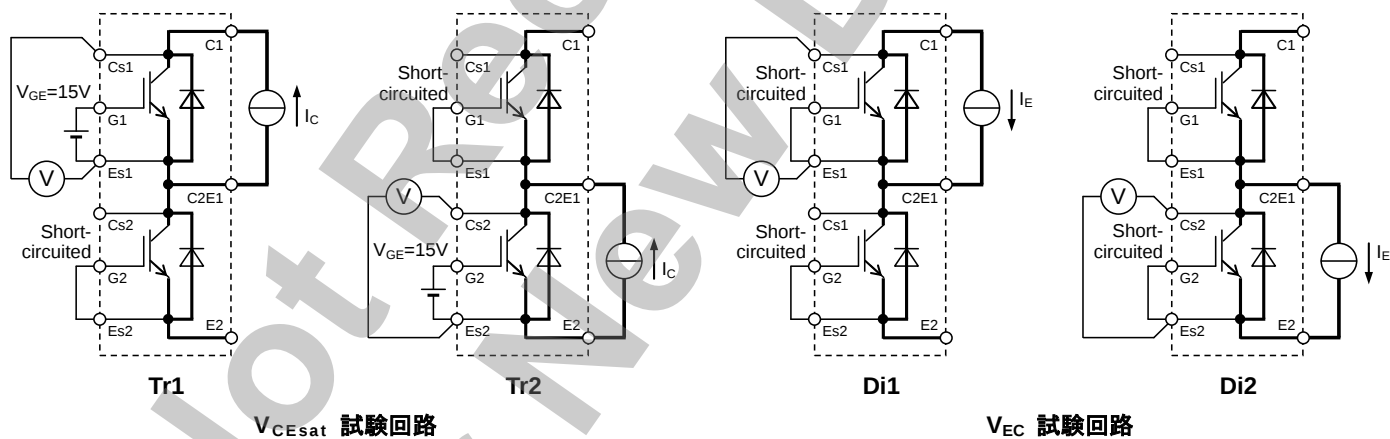
IGBT ターンオフスイッチング損失



FWD 逆回復損失

ターンオン / ターンオフスイッチング損失及び逆回復損失試験波形 (積分時間説明図)

試験回路

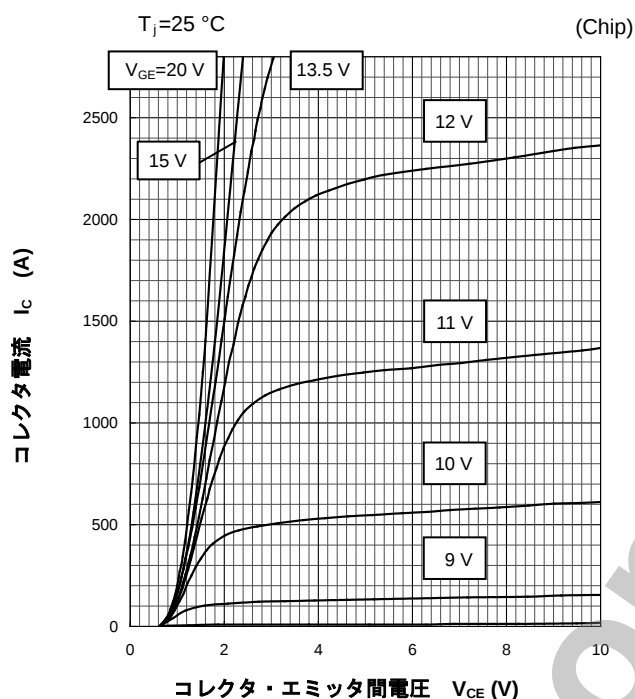


V_{CEsat} 試験回路

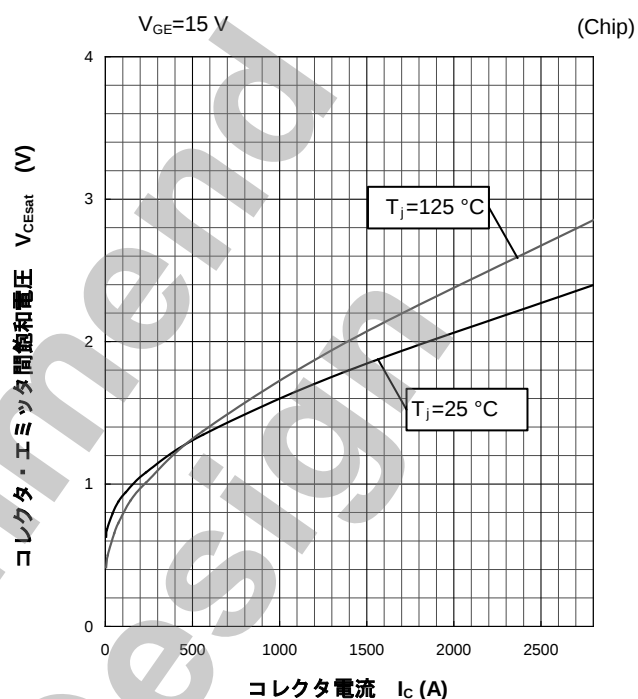
V_{CE} 試験回路

特性図

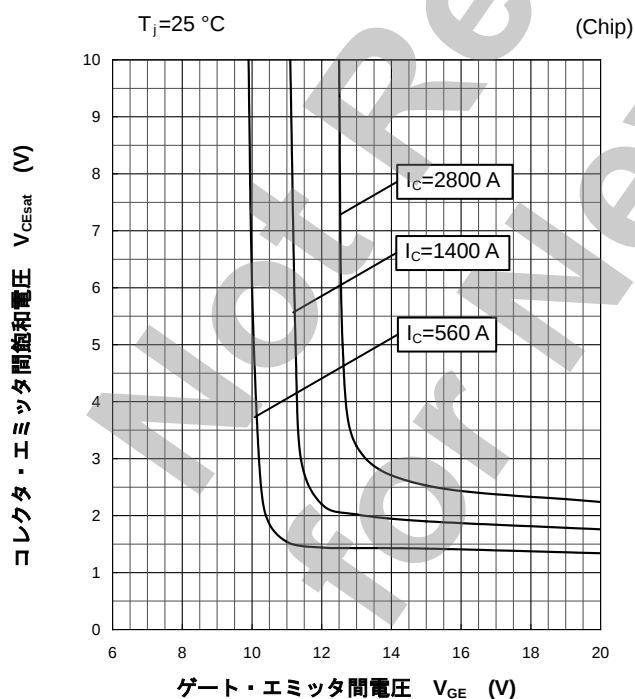
出力特性
(代表例)



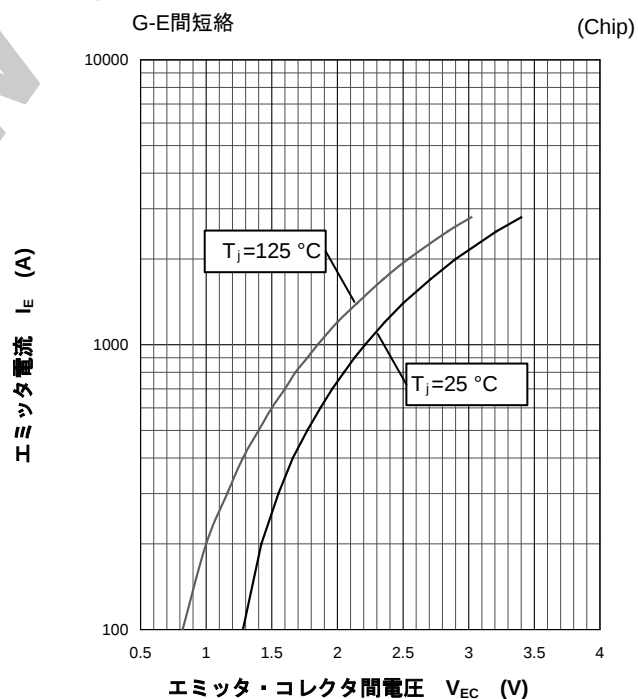
コレクタ・エミッタ間飽和電圧特性
(代表例)



コレクタ・エミッタ間飽和電圧特性
(代表例)



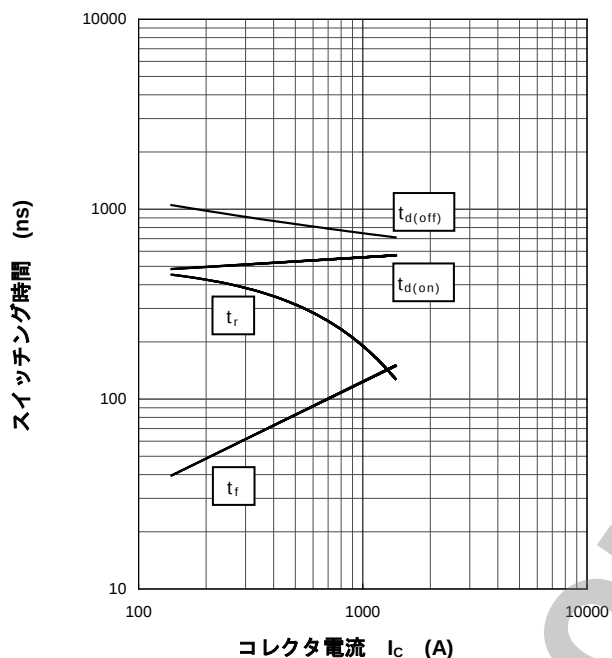
フリーホイールダイオード順特性
(代表例)



特性図

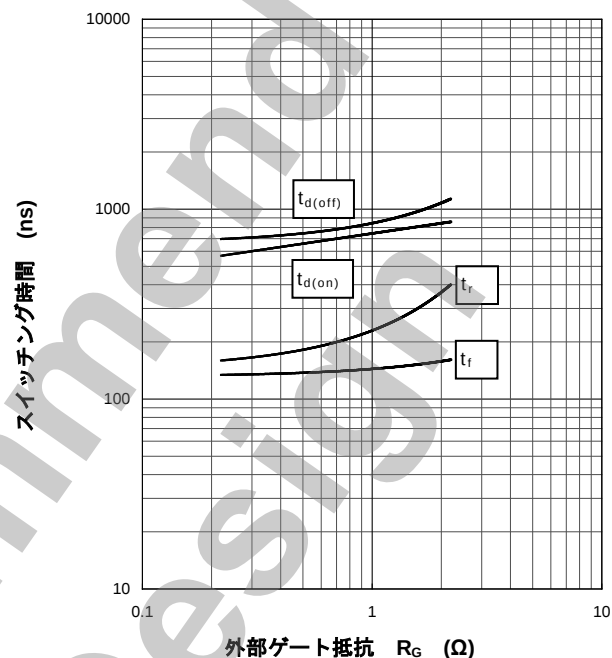
スイッチング時間特性
(代表例)

$V_{CC}=600\text{ V}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, $R_G=0.22\ \Omega$, 誘導負荷, $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$



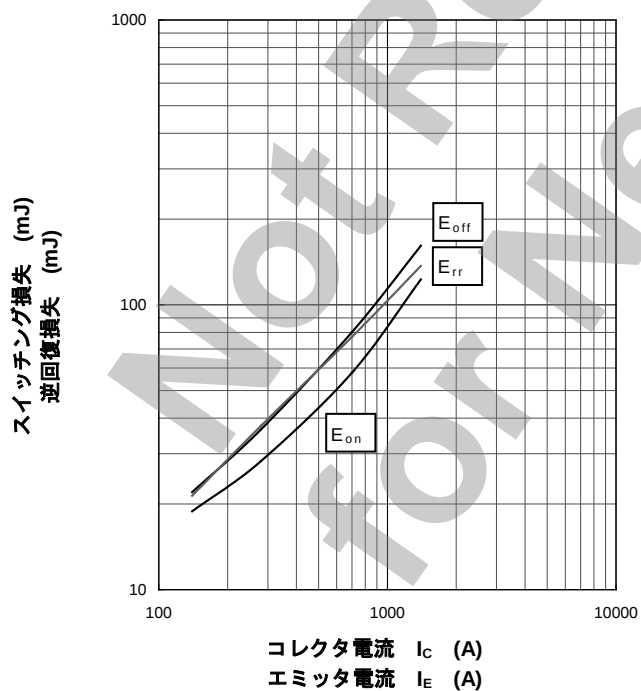
スイッチング時間特性
(代表例)

$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_C=1400\text{ A}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, 誘導負荷, $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$



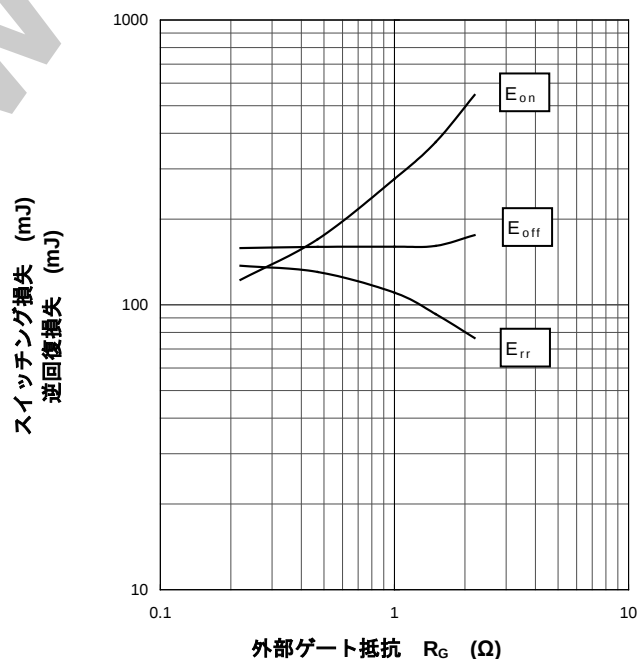
スイッチング損失特性
(代表例)

$V_{CC}=600\text{ V}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, $R_G=0.22\ \Omega$, 誘導負荷,
1パルスあたり, $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$



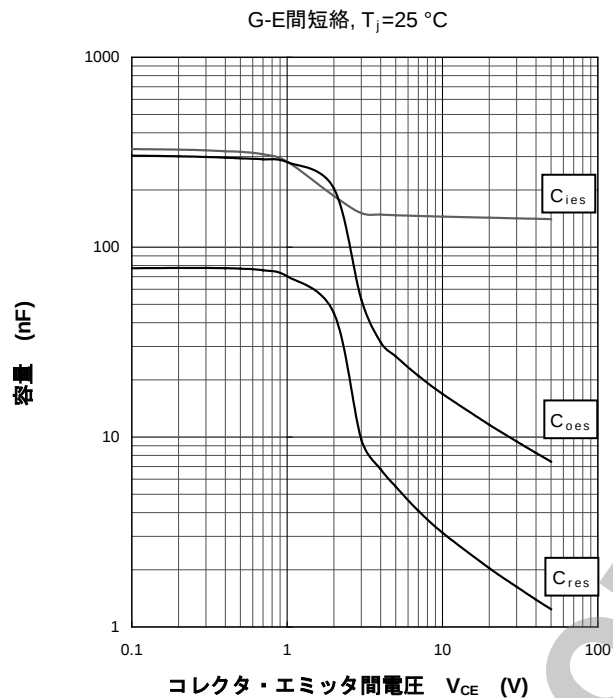
スイッチング損失特性
(代表例)

$V_{CC}=600\text{ V}$, $I_C/I_E=1400\text{ A}$, $V_{GE}=\pm 15\text{ V}$, 誘導負荷,
1パルスあたり, $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$

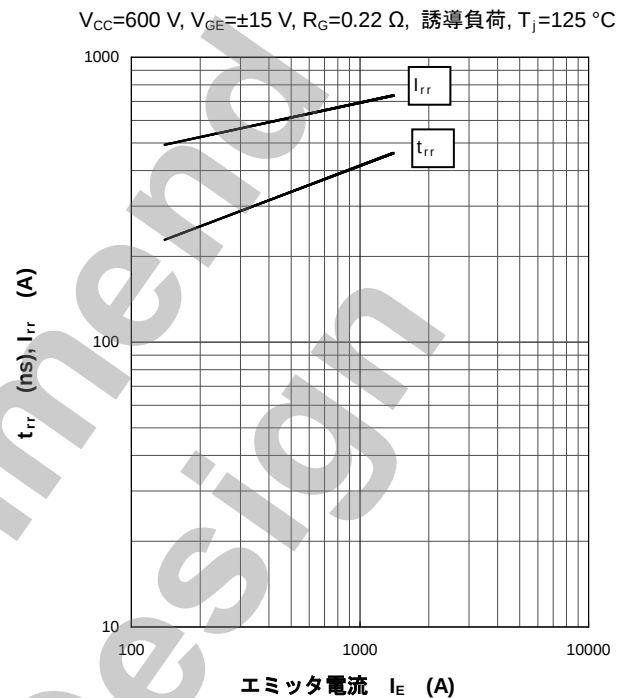


特性図

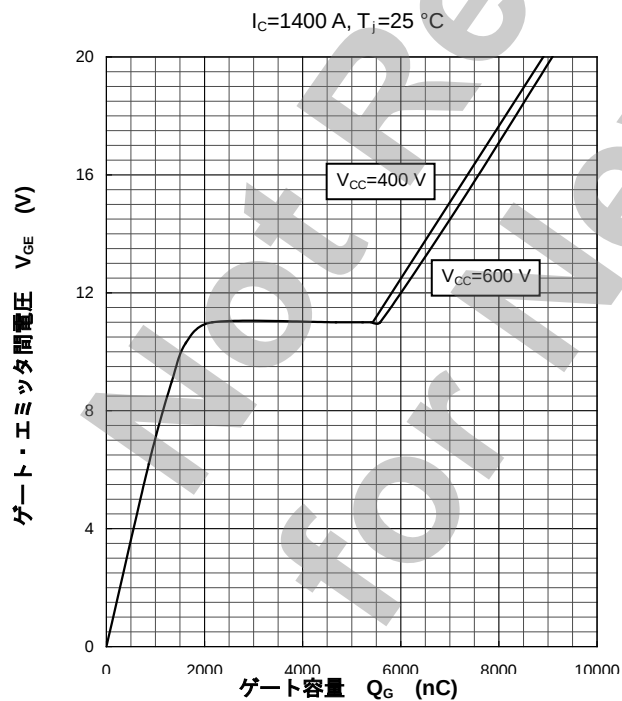
容量特性
(代表例)



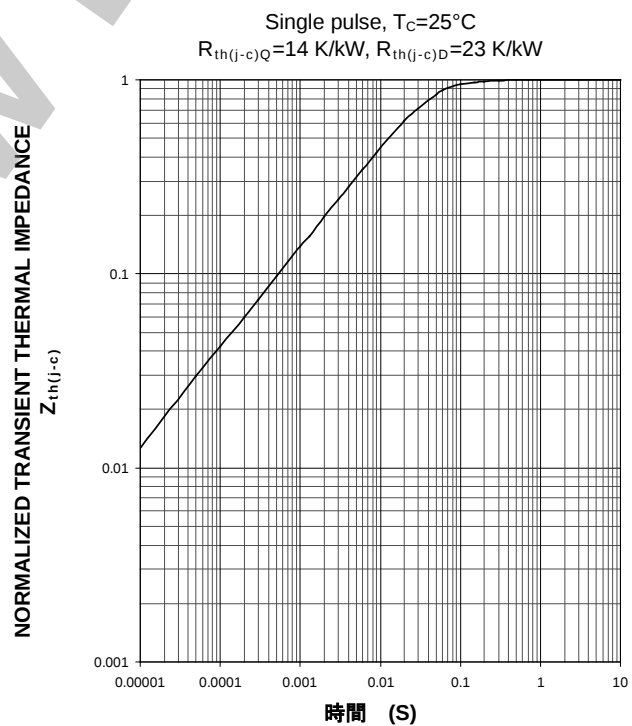
フリーホイールダイオード回復特性
(代表例)



ゲート容量特性
(代表例)



最大過渡熱インピーダンス特性



安全設計に関するお願い

弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品又は仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たっては、事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ（www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/）などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したのですが、万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。